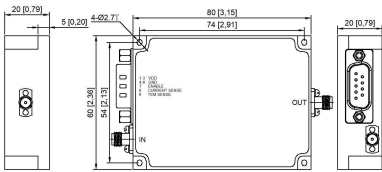


مضخم قدرة GaN RF، 2000–3000 MHz، نموذجي 50 W



يوفر مضخم GaN خرجًا مشبعًا نموذجيًا 50 W على 2000–3000 MHz وكسبًا نموذجيًا 47 dB. الاستواء النموذجي ±1 dB؛ قياس التوافقيات -12 dBc - النموذجي محدد عند خرج 30 W.

المواصفات الكهربائية · Pin=0dBm; +28.0VDC; 25°C; 50Ω

المعامل	الرمز	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة
تردد التشغيل	BW	2000	-	3000	MHz
قدرة خرج RF @ PSAT	PSAT	-	50	-	W
كسب القدرة @ PSAT	Gp	-	47	-	dB
استواء كسب القدرة @ PSAT	ΔGp	-	±1	-	dB
فقد العودة عند الدخل	S11	-	-	-10	dB
التوافقيات عند 30 W	H	-	-12	-	dBc
الإشارات الطفيلية @ PSAT	Spur	-	-50	-	dBc
ممانعة الدخل/الخرج	Impedance	-	50	-	Ω
جهد التشغيل	VDC	-	28	32	VDC
كفاءة القدرة المضافة	Eff	-	30	-	%

القيم القصوى المطلقة

المعامل	القيمة المقننة
قدرة دخل RF دون تلف	+10 dBm الحد الأقصى
VSWR الحمل	6:1؛ جميع أطوار الحمل وسعته؛ مستمر
الحمل الحراري الزائد	85 °C ±5 °C → إيقاف التشغيل (الحد الأقصى)

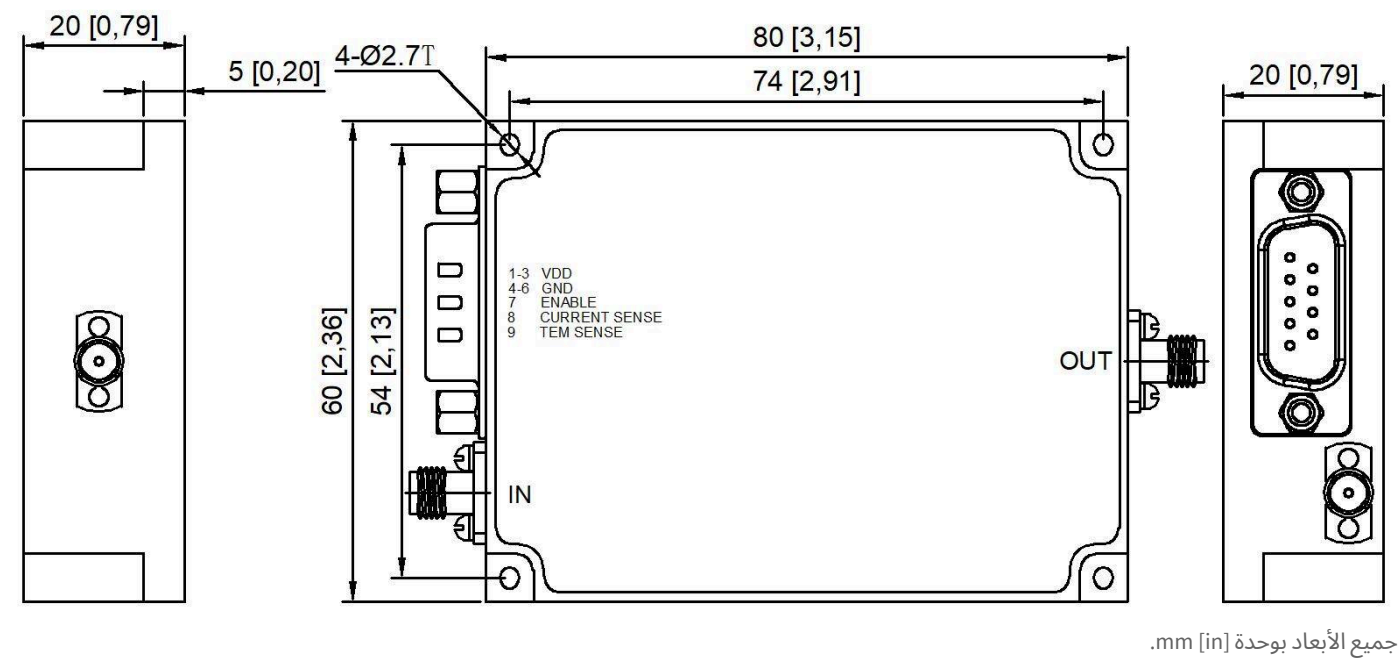
المواصفات البيئية · أهداف تصميم؛ يلزم تأكيدها للمشروع

المعامل	الحد الأدنى	القيمة النموذجية	الحد الأقصى	الوحدة	ملاحظات
درجة حرارة التشغيل	-20	-	55	°C	-
درجة حرارة التخزين	-40	-	85	°C	درجة حرارة التخزين
الرطوبة النسبية (دون تكاثف)	-	-	95	%	-

المواصفات الميكانيكية - يخصص جدول المصدر الطرف 8 لاستشعار الحرارة والطرف 9 لاستشعار التيار، بينما يعكس الرسم الأصلي هاتين الوظيفتين. يجب تأكيد الطرفين 8/9 قبل التوصيل.

المعامل	القيمة	الوحدة
الأبعاد	80 × 60 × 20 [3.15 × 2.36 × 0.78] mm [in]	mm [in]
الوزن	0.5 [1.1] kg [lb]	kg [lb]
موصل دخل RF	J1:SMA، أنثى	-
موصل خرج RF	J2:SMA، أنثى	-
واجهة DC والتحكم	J3:DB9، ذكر	-

مخطط الأبعاد الميكانيكية



جميع الأبعاد بوحدة mm [in]

واجهة DC والتحكم

رقم الطرف	الوصف	المواصفة
1-3	— 1-3 تغذية موجبة	28VDC~32VDC
4-6	— 4-6 الأرضي	الأرضي
7	— 7 التمكين	مستوى TTL مرتفع (3.3 V)؛ سحب داخلي إلى المستوى المنخفض

ملاحظة حول المستند

قد تخضع المواصفات للمراجعة. قبل اعتماد التصميم، تأكد من LCRF من مراجعة المستند الحالية والمتطلبات الخاصة بالمنتج. يحدد عرض السعر المعتمد ووثائق الطلب التكوين المورد.